

Silicon-Diode

1N662

80V / 40mA

DATASHEET

OEM – Texas Instruments

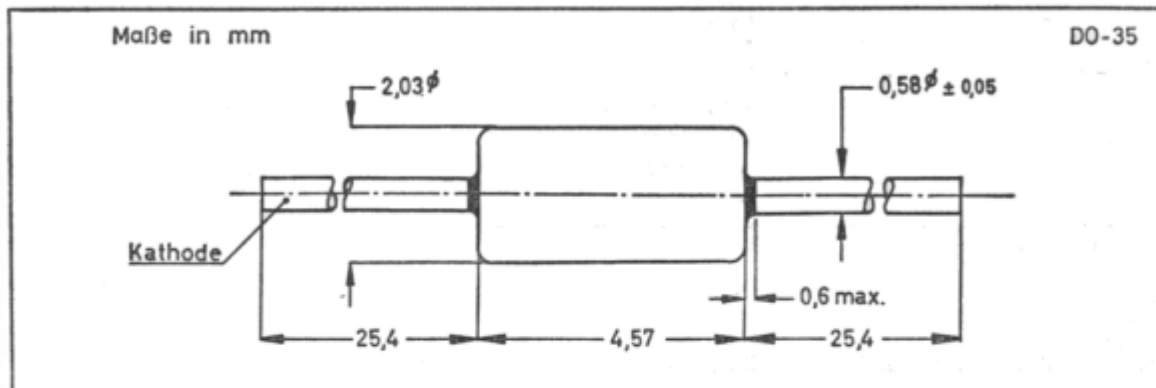
Source: Texas Instruments Databook 1968/69

Diffundierte Silizium-Schaltdiode

1N662 und 1N663

Mechanische Daten

Das glaspassivierte Silizium-Kristall ist in einem Glasgehäuse hermetisch abgeschlossen. Hochtemperatur-Verbindungsstellen zwischen Kristall und Kontaktanschlüssen garantieren einen guten Kontakt, selbst bei extremsten Umweltbedingungen.



Absolute Grenzwerte

	1N662 und 1N663
*Sperrspannung	← 80 V →
*Richtstrom bei (oder unter) 25 °C Umgebungstemperatur (Bem. 1)	40 mA 60 mA
*Spitzenstoßstrom für die Dauer von 1 s (Bem. 2)	← 0,5 A →
*Spitzenstoßstrom für die Dauer von 0,3 s (Bem. 2)	← 1 A →
*Spitzenimpulsstrom (Bem. 3)	← 2 A →
Dauerverlustleistung bei (oder unter) 25 °C Umgebungstemperatur (Bem. 4)	← 250 mW →
*Umgebungstemperatur-Arbeitsbereich	-65 °C bis +150 °C
*Lagerungstemperatur	-65 °C bis +150 °C

Bemerkungen:

1. Dieser Wert wird bei Einphasenbetrieb von 50 Hz (Sinushalbwellen) mit Widerstandslast garantiert. Reduziert sich linear auf 0 bei 150 °C T_U.
2. Dieser Wert gilt bei einem Rechteckimpuls.
3. Dieser Wert gilt für: t_p ≤ 1 μs, Tastverhältnis ≤ 1%.
4. Lineare Reduzierung auf 150 °C T_U mit 2 mW/°C.

* JEDEC registriert.

Elektrische Kennwerte* bei $T_U = 25\text{ °C}$ (wenn nicht anders angegeben)

Parameter	Prüfbedingungen	1N662		1N663		Einh.
		min	max	min	max	
$U_{(BR)}$ Durchbruchspannung	$I_R = 100\ \mu\text{A}$	100		100		V
I_R Sperrstrom	$U_R = 10\ \text{V}$		1			μA
	$U_R = 50\ \text{V}$		20			μA
	$U_R = 75\ \text{V}$			5		μA
	$U_R = 10\ \text{V}, T_U = 100\text{ °C}$		20			μA
	$U_R = 50\ \text{V}, T_U = 100\text{ °C}$		100			μA
U_F Flußspannung	$I_F = 10\ \text{mA}$		1			V
	$I_F = 100\ \text{mA}$			1		V

Schaltzeit-Kennwerte* bei $T_U = 25\text{ °C}$ (wenn nicht anders angegeben)

Parameter	Prüfbedingungen	1N662		1N663		Einh.
		min	max	min	max	
t_{rr} Sperrverzögerungszeit	256-JAN, $I_F = 5\ \text{mA}$, $U_R = 40\ \text{V}$, $R_L = 2,3\ \text{k}\Omega$, $C_L = 40\ \text{pF}$, Erholung auf $100\ \text{k}\Omega$		0,5			μs
	256-JAN, $I_F = 5\ \text{mA}$, $U_R = 40\ \text{V}$, $R_L = 2,3\ \text{k}\Omega$, $C_L = 40\ \text{pF}$, Erholung auf $200\ \text{k}\Omega$				0,5	μs

* JEDEC registriert.